



## 1. 产品介绍

HM41F是一款耐高压双极霍尔开关芯片，采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式：输入磁感应强度，输出为数字电压信号。该芯片具有可耐高电压冲击，具有极强的抗噪能力；适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等领域。提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式，且封装都符合RoHS标准。

## 2. 特征

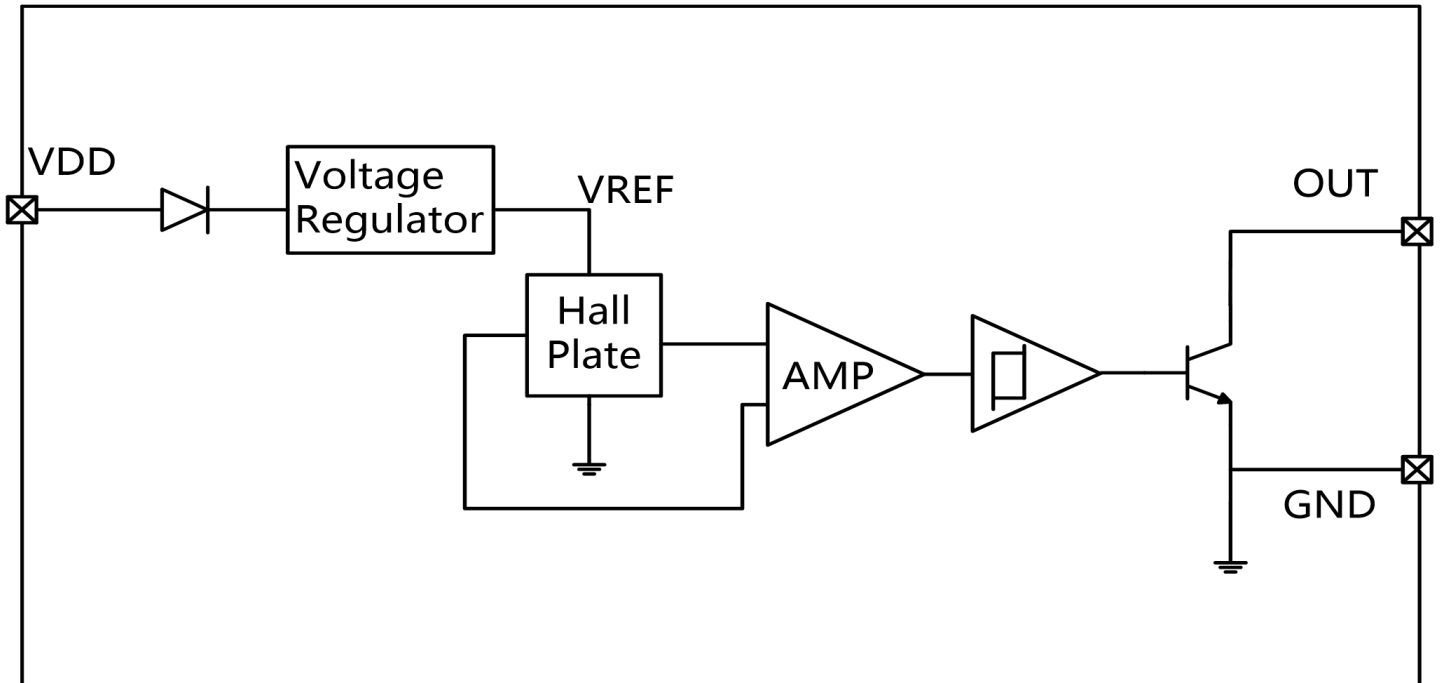
- 工作电压：3.8V~60V
- 过压保护能力：80V
- ESD 性能：±4 kV
- 集电极开路输出
- 电源引脚反向电压保护
- 可驱动电流最大 30mA
- 工作温度范围：-40°C~150°C

## 3. 典型应用

- 无刷直流电机换向
- 速度测量
- 计数
- 角位置检测
- 接近检测
- 适用于汽车和极端工业环境

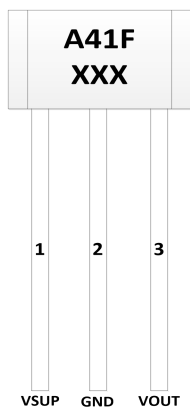
## 4. 功能框图

该耐高压双极霍尔开关芯片包括电压调制电路、霍尔片、信号放大电路和施密特触发器电路。其中电压调制电路为霍尔片提供参考电压，该霍尔片感应到垂直于传感器表面的磁场产生霍尔电压，放大后发送给施密特触发器。同时该芯片还集成了反向电源的保护二极管，用于保护芯片免于反向电压的击穿。

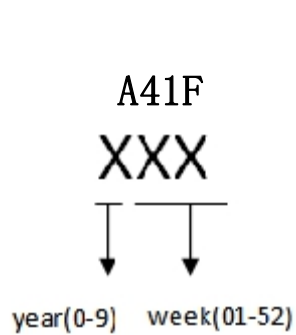


HM41F 功能框图

## 5. 引脚信息



T092S



SOT23-3L

芯片引脚号	名称	说明
1	VSUP	电源
2	GND	地
3	VOUT	集电极开路输出，需外接上拉电阻

## 6. 订购信息

编号	封装	包装	工作温度范围
HM41FT	TO92S	1000 / 袋	-40°C~150°C
HM41FMR	SOT23-3L	3000 / 卷	-40°C~150°C

## 7. 绝对最大额定

符号	参数	最小值	最大值	单位
$V_{SUP}$	电源电压	-60	80	V
$V_{OUT}$	输出电压	-0.5	80	V
$I_{OUT}$	输出电流	0	40	mA
$T_J$	工作温度	-40	150	°C
$T_{STG}$	存储温度	-50	165	°C

绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值，超过该值芯片可能会永久损坏。

## 8. 电磁特性

测试条件： $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ ， $V_{SUP} = 3.8\text{V} \sim 60\text{V}$ ；典型值测试条件： $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{SUP} = 5\text{V}$ 。

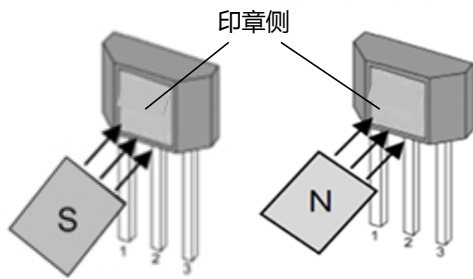
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电特性</b>						
$V_{SUP}$	电源电压		3.8		60	V
$I_{SUP}$	电源电流			4.8	8	mA

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{leak}$	输出漏电流				10	uA
$V_{sat}$	输出电压	$I_{OUT}=20mA$			0.4	V
$I_{OUT}$	输出电流				30	mA
$T_r$	输出上升时间	$R_L=10K\Omega$ , $C_L=20pF$			1.0	us
$T_f$	输出下降时间	$R_L=10K\Omega$ , $C_L=20pF$			1.5	us
<b>磁特性</b>						
Bop	工作点	$R_L=10K\Omega$ , $C_L=20pF$	10	45	80	Gauss
Brp	释放点	$R_L=10K\Omega$ , $C_L=20pF$	-80	-45	-10	Gauss
$B_{HYS}$	回差			90		Gauss

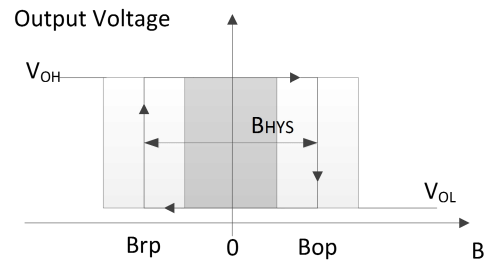
## 9. 磁电转换说明

在TO92S封装的印章侧施加大于Bop的磁场（南极靠近），输出变为低电平；施加小于Brp的磁场（北极靠近），输出变为高电平。芯片初次上电时，如果磁场处于Bop和Brp之间，输出状态会处于未定义的状态（高电平或低电平）。SOT23-3L封装的工作点与释放点的磁场极性与TO92S相反。

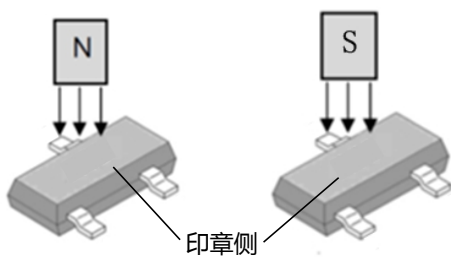
见下图。



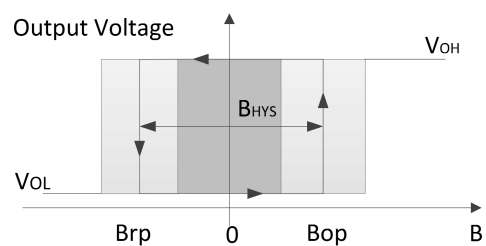
$V_{OUT}$ =低电平       $V_{OUT}$ =高电平



TO92S输出状态



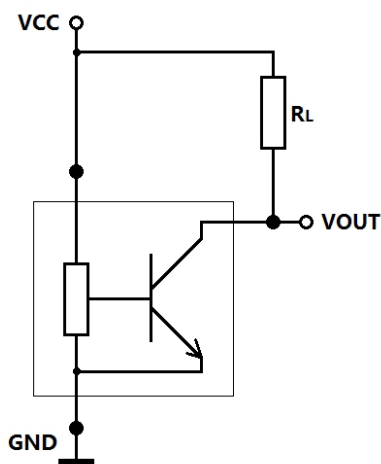
$V_{OUT}$ =低电平       $V_{OUT}$ =高电平



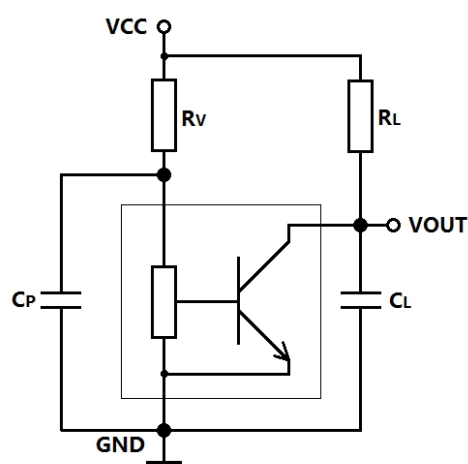
SOT23-3L输出状态

## 10. 应用电路

典型应用电路见下图中:应用电路1, 其中 $R_L = 4.7K\Omega$ , 可应用与大多数电路。应用电路2, 其中 $R_V = 100\Omega$ ,  $C_P = 4.7nF$ ,  $R_L = 4.7K\Omega$ ,  $C_L = 1nF$ , 应用于供电线上具有干扰或辐射干扰的电路, 建议在电路中串联电阻 $R_V$ 和两个电容 $C_P$ 、 $C_L$ , 且将电阻和电容这些元器件尽量放置在接近芯片处。



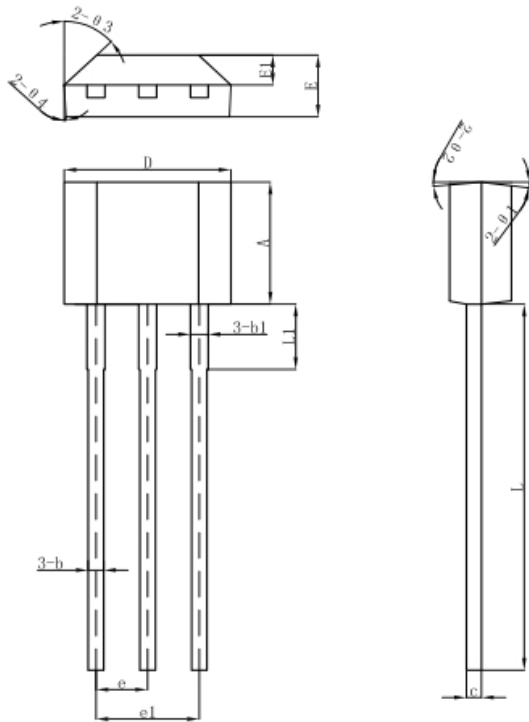
应用电路 1



应用电路 2

## 11. 外形尺寸

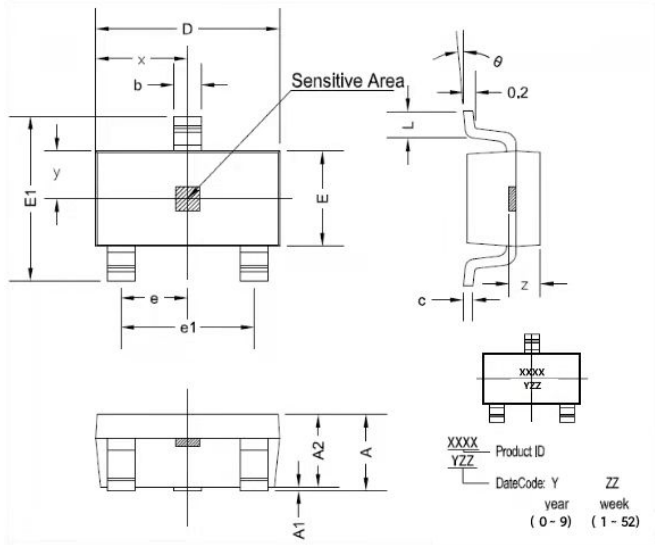
### TO92S 封装尺寸



	机械尺寸/mm		
符号	最小	典型	最大
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.40
b1		0.44	
c	0.36	0.38	0.40
D	4.00	4.10	4.20
E	1.42	1.52	1.62
E1		0.75	
e		1.27	
e1		1.27	
L1		2.54	
L	13.50	14.50	15.50
$\theta 1$		6°	
$\theta 2$		3°	

θ3		45°	
θ4		3°	
h		3.6	

SOT23-3L 封装尺寸



符号	尺寸（毫米）		尺寸（英尺）	
	最小	最大	最小	最大
A	1.05	1.25	0.041	0.049
A1	0	0.1	0	0.004
A2	1.05	1.15	0.041	0.045
b	0.3	0.5	0.012	0.02
c	0.100	0.2	0.004	0.008
D	2.82	3.02	0.111	0.119
E	1.5	1.7	0.059	0.067
E1	2.65	2.95	0.104	0.116
e	0.950 TYP		0.037 TYP	
e1	1.8	2	0.071	0.079
L	0.3	0.6	0.012	0.024
x	1.460 TYP		0.057 TYP	
y	0.800 TYP		0.032 TYP	
z	0.600 TYP		0.024 TYP	
θ	0°	8°	0°	8°

## 12. 注意事项

- 霍尔芯片是敏感器件，在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。
- 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。
- 建议焊接温度不超过 350℃，持续时间不超过 5 秒。
- 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性，不建议长期超出参数范围使用。